

при $T = +85^{\circ}\text{C}$	15 мкА
Входное сопротивление транзистора в режиме малого сигнала (h_{116})	6 .. 70 Ом

** по некоторым источникам*

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база и коллектор-эмиттер ¹ при $R_{эб} < 10 \text{ кОм}$	
ПЗ07, ПЗ07А, ПЗ07Б, ПЗ07Г	80 В
ПЗ07В	60 В (80 В)*
ПЗ08, ПЗ09	120 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	3 В
Постоянный ток коллектора	
ПЗ07, ПЗ07В, ПЗ08, ПЗ09	30 мА
ПЗ07Б, ПЗ07Г	15 мА (30 мА)*
Постоянный ток эмиттера	30 мА
Импульсный ток коллектора при $t_{и} < 1 \text{ мкс}$, $Q > 10$	120 мА
Постоянная рассеиваемая мощность ²	
при $T < +20^{\circ}\text{C}$	250 мВт
при $T = +60^{\circ}\text{C}$	200 мВт
при $T = +85^{\circ}\text{C}$	168,75 мВт
при $T = +100^{\circ}\text{C}$	150 мВт
при $T = +120^{\circ}\text{C}$	100 мВт
при $T = +125^{\circ}\text{C}$	87,5 мВт
Общее тепловое сопротивление	
при $T < +100^{\circ}\text{C}$	0,8 $^{\circ}\text{C}/\text{мВт}$
при $T > +100^{\circ}\text{C}$	0,4 $^{\circ}\text{C}/\text{мВт}$
Температура перехода	+150 $^{\circ}\text{C}$
Температура окружающей среды	-40 ... +85 $^{\circ}\text{C}$ (-40 ... +75 $^{\circ}\text{C}$; ... +120 $^{\circ}\text{C}$)*
Атмосферное давление	5 мм рт. ст.
Относительная влажность при +40 $\pm$ 5 $^{\circ}\text{C}$	95 ... 98%
Термоциклирование в диапазоне температур	-40 ... +70 $^{\circ}\text{C}$
Постоянные ускорения (макс.)	75 g
Вибрация в диапазоне 10 ... 600 гц (макс.)	7,5 g

** по некоторым источникам*

1. Допускается включение сопротивления в цепи базы $R_b < 100 \text{ кОм}$ при $T = +60^{\circ}\text{C}$, если $R_{э} \geq R_b$
2. Значение $R_{к \text{ макс}}$ в интервале температур +20 ... +85 $^{\circ}\text{C}$ уменьшается линейно со скоростью 1,25 мВт/ $^{\circ}\text{C}$.

Указания по эксплуатации

Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора. Пайку производить паяльником при $T < 260^{\circ}\text{C}$ в течение не более 10 с. Необходимо осуществить теплоотвод между корпусом и местом пайки.

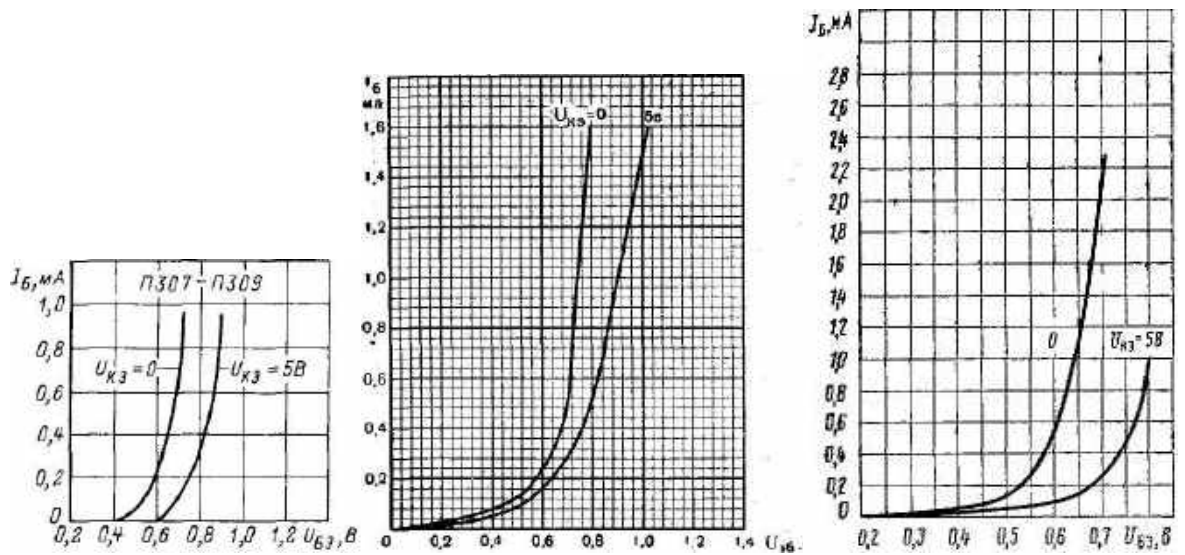
Изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 3 мм от корпуса, при этом должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие неподвижность вывода между изгибом и стеклянным изолятором, чтобы не произошло нарушения спая выводов со стеклянным изолятором, ведущего к потере герметичности транзистора. При изгибе вывода на расстоянии от 3 до 5 мм необходимо применять специальные шаблоны.

При эксплуатации транзисторов в условиях механических воздействий транзисторы необходимо крепить за корпус.

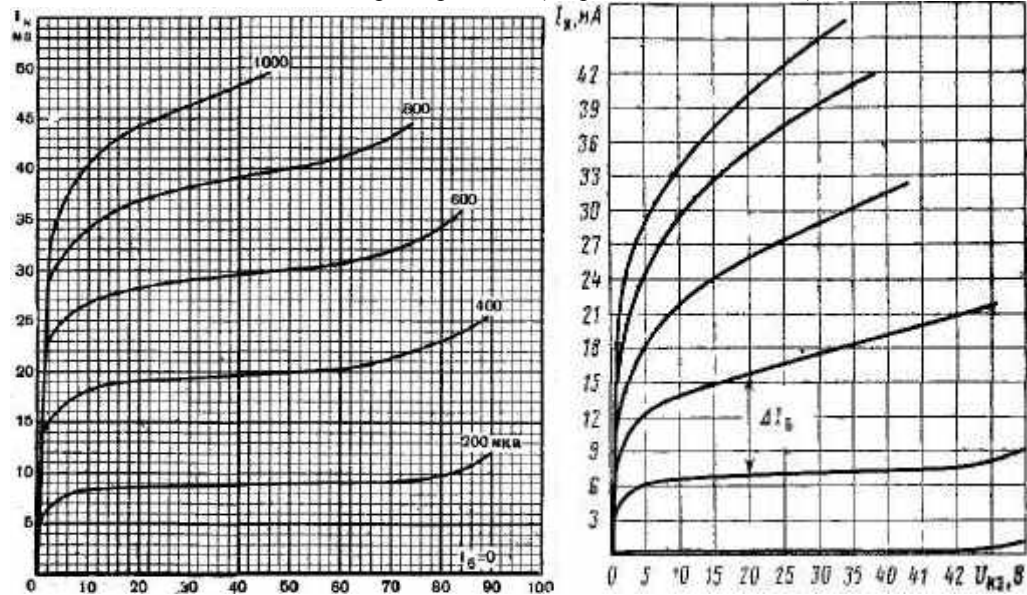
При изменении электрических параметров возможно паразитное самовозбуждение транзистора, особенно если он соединён со схемой длинными выводами. Для устранения паразитного самовозбуждения рекомендуется эмиттер, коллектор и базу соединять с землей с помощью конденсаторов. Присоединение развязывающих емкостей к выводам должно производиться непосредственно у основания транзистора. Если базовая цепь содержит значительную паразитную индуктивность, то конденсаторы подсоединяются между эмиттером и базой и между коллектором и базой.

При включении транзисторов в схему, находящуюся под напряжением, базовый контакт должен присоединяться первым и отключаться последним.

Входные характеристики (по разным источникам)

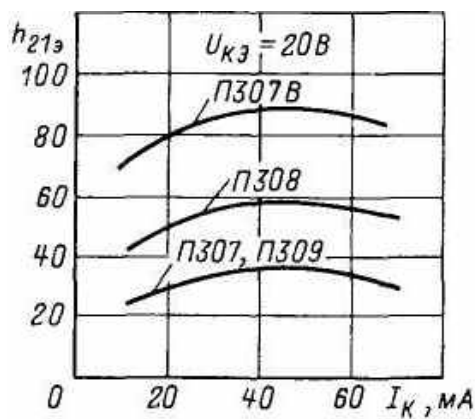


Выходные характеристики (по разным источникам)

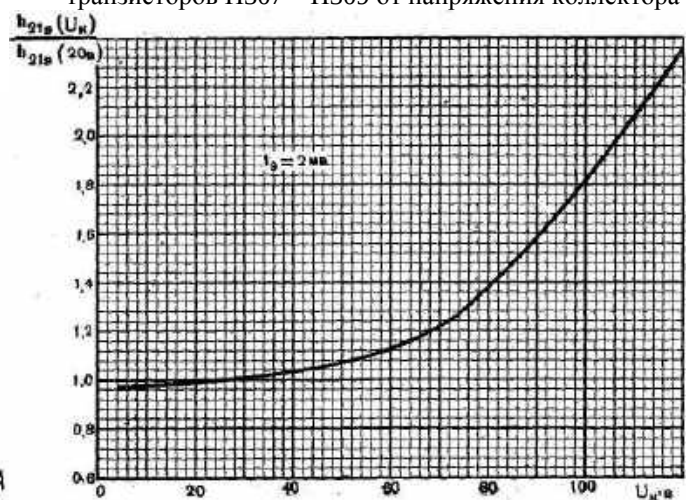


ПЗ07, ПЗ07Г, ПЗ09 – $\Delta I_{б} = 350\text{мкА}$
 ПЗ07А, ПЗ08 – $\Delta I_{б} = 200\text{мкА}$
 ПЗ07Б, ПЗ07В – $\Delta I_{б} = 100\text{мкА}$

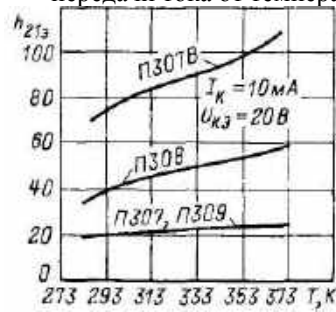
Зависимость коэффициента передачи тока от тока коллектора



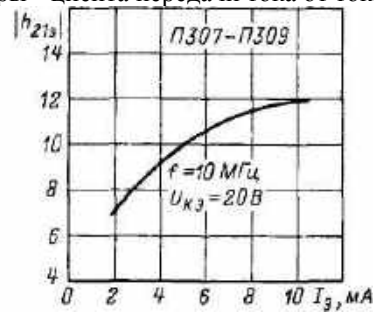
Типовая зависимость коэффициента усиления по току транзисторов ПЗ07—ПЗ09 от напряжения коллектора



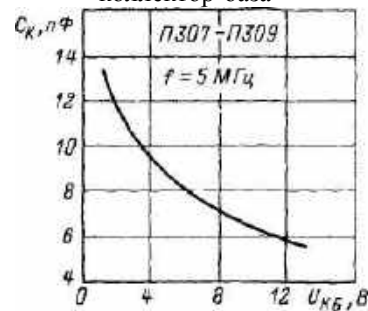
Зависимость коэффициента передачи тока от температуры



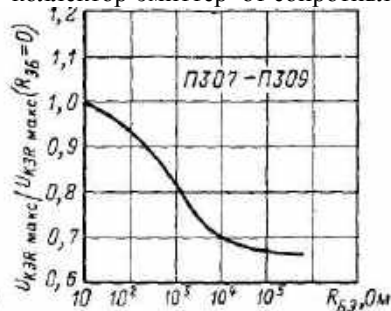
Зависимость модуля коэффициента передачи тока от тока эмиттера



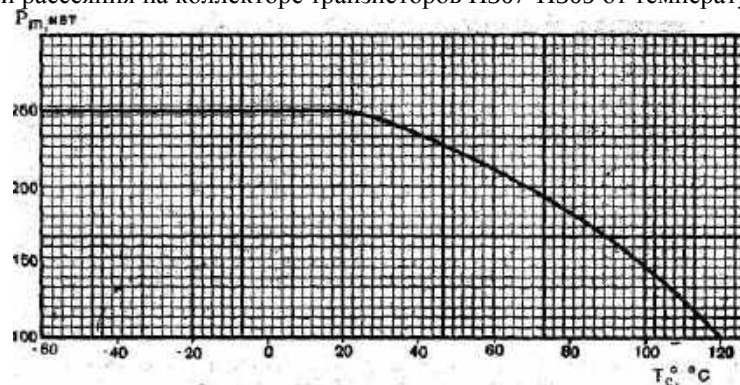
Зависимость емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор-база



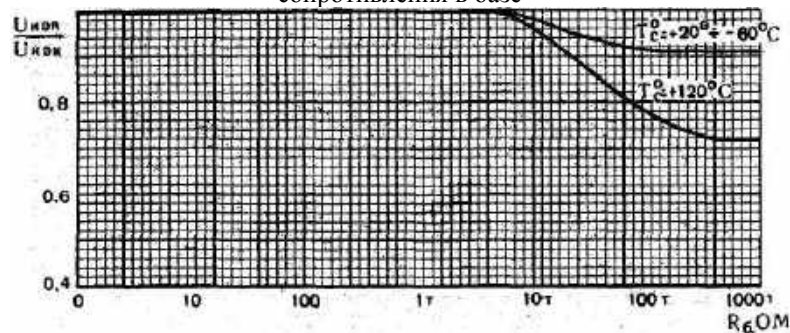
Зависимость относительного максимально допустимого напряжения коллектор-эмиттер от сопротивления база-эмиттер



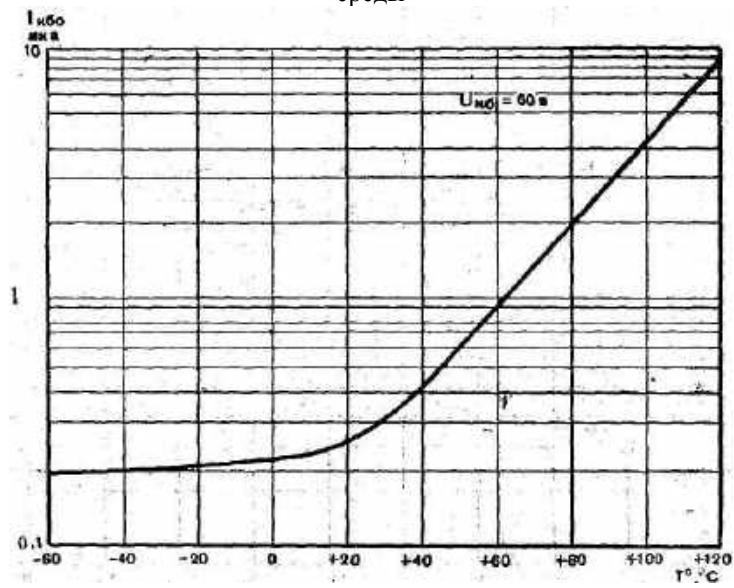
Зависимость мощности рассеяния на коллекторе транзисторов ПЗ07-ПЗ09 от температуры окружающей среды



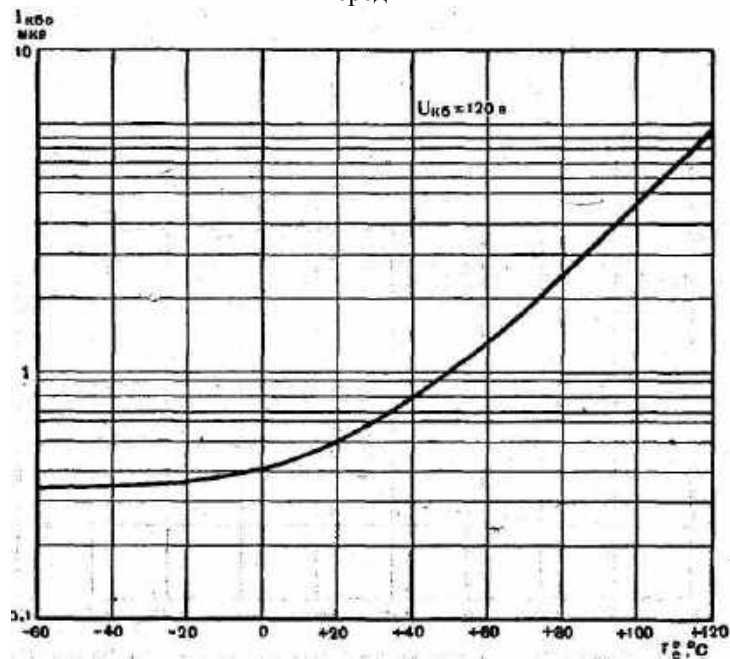
Зависимость предельно допустимого напряжения коллектор-эмиттер транзисторов ПЗ07-ПЗ09 от сопротивления в базе



Типовая зависимость тока коллекторного перехода транзисторов ПЗ07-ПЗ07Г от температуры окружающей среды



Типовая зависимость тока коллекторного перехода транзисторов ПЗ08-ПЗ09 от температуры окружающей среды



Зависимость сопротивления насыщения транзисторов ПЗ07—ПЗ09 от температуры окружающей среды

